

ライナック電子線低温照射装置

1. 概要

低温で材料の高エネルギー電子線照射が可能な装置である。

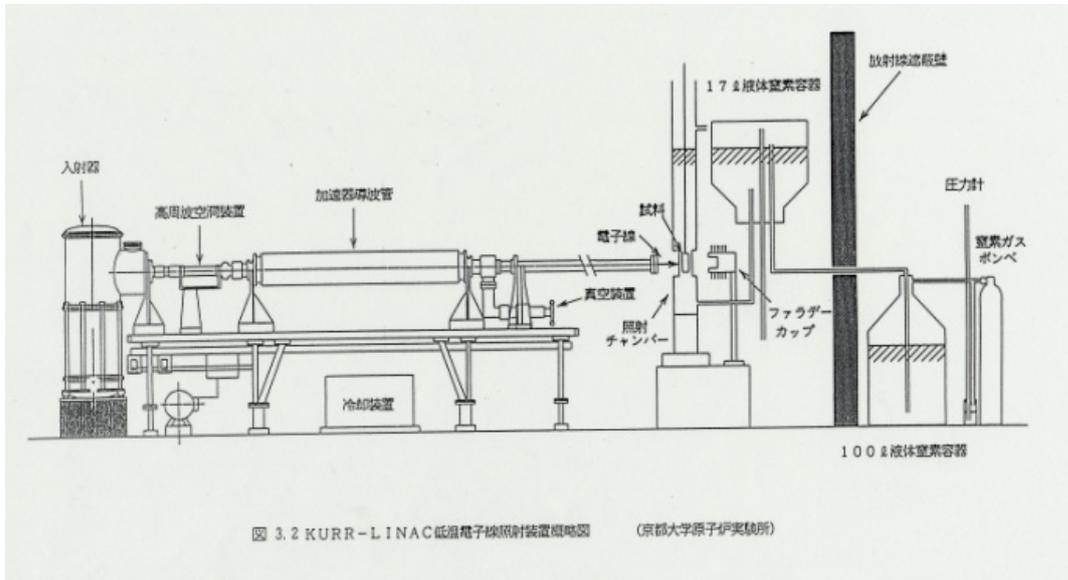


図 1. ライナック電子線低温照射装置

2. 特性

照射温度：100K、電子線のエネルギー10MeV～30MeV

3. 設置場所

電子線型加速器施設（中性子発生装置室）

4. 提出書類

実験計画に使用の旨を記載、管理区域立入願

5. 装置担当者

木野村淳（2682）、徐虬(2417)